

Table 1: Вихідні дані

напруга живлення	$E, \text{ В}$	15
напруга логічної одиниці (не менше)	$U^1, \text{ В}$	8
напруга логічного нуля (не більше)	$U^0, \text{ В}$	0,7
струм через навантажувальні транзистори	$I_{load}, \text{ мкА}$	180
ємність навантаження	$C_{load}, \text{ нФ}$	53
час включення	$t_{ON}, \text{ нс}$	150
час виключення	$t_{OFF}, \text{ нс}$	520
товщина затвору	$d_G, \text{ мкм}$	0,7
легування затвору з Si*	$N_G, 10^{18} \text{ см}^{-3}$	4,6
щільність поверхневих станів	$N_{SS}, 10^{11} \text{ см}^{-3}$	4,6
товщина підзатворного діелектрика	$d_{ox}, \text{ нм}$	90
доза легування вбудованого каналу	$D_S, \text{ мкКл} / \text{ см}$	0,2
глибина вбудованого каналу	$x_{ch}, \text{ мкм}$	0,33